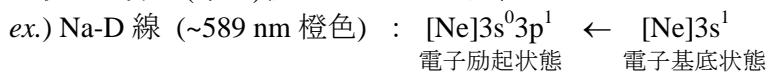


5. 電子遷移

= 電子状態変化 (による光吸収・発光)

電子状態：分子(原子)軌道への電子の配置



5.1 電子スピン

= 電子の自転の角運動量

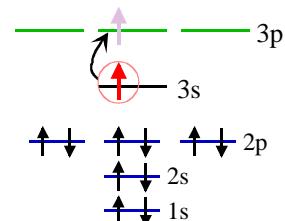
$$s(\text{電子1個のスピン量子数}) = 1/2 \quad (5.1)$$

$$S(\text{分子全体のスピン量子数}) = 0, 1/2, 1, 3/2, \dots \quad (5.2)$$

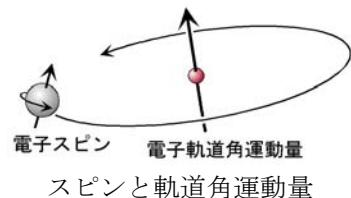
* S には不対電子のみ寄与

$$\text{スピン多重度} = 2S + 1 \quad (5.3)$$

磁場中で、エネルギー状態が $2S + 1$ 個に分裂する



Na-D 線の電子遷移



スピン多重度

	一重項	二重項	三重項
不対電子数	0	1	2
S スピン量子数	0	$1/2$	1
M_S S の z 軸射影 (磁場中の量子化)	0	$-1/2 \quad +1/2$	$-1 \quad 0 \quad +1$
$2S + 1$ スpin多重度	1	2	3
例	He, H ₂ , CH ₄ , CH ₂ O(S ₀ , 基底状態)	NO, CH ₃ (ラジカル)	O ₂ , CH ₂ O(T ₁ , 励起状態)

→ 一重項, 二重項, ...

5.2 電子軌道角運動量

= 電子の(分子軌道中)公転の角運動量

[原子]

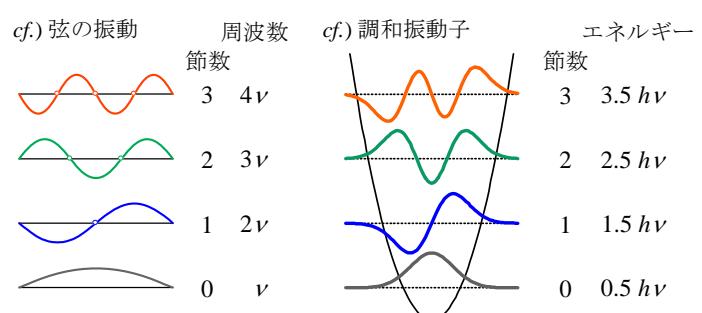
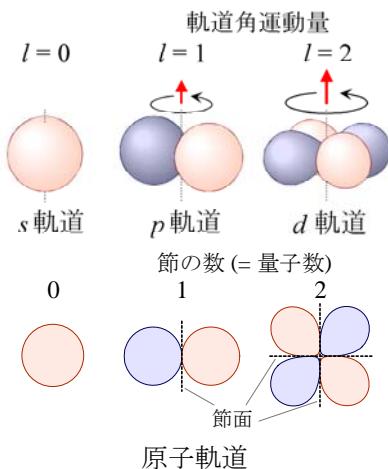
$$l(\text{原子軌道の角運動量量子数}) = 0, 1, 2, \dots \quad (5.4)$$

→ s 軌道, p 軌道, d 軌道, ...

$$L(\text{原子全体の角運動量量子数}) = 0, 1, 2, \dots \quad (5.5)$$

→ S 状態, P 状態, D 状態, ...

* L には不対電子のみ寄与



多重度

$$g_L = 2L + 1 \quad (5.6)$$

電子状態の多重度(含むスピン)

$$g_e = (2S + 1)(2L + 1) \quad (5.7)$$

 $2S+1[L]$ ←

原子の電子状態(スペクトル項)

	Na	F
電子配置	[Ne]3s ¹ 3s ↑	[He]2s ² 2p ⁵ 2p ↑↓↑↓↑
2S + 1	2	2
L	0 (s軌道に1)	1 (p軌道に1)
電子状態 (スペクトル項)	² S (doublet - S) 二重項の S 状態	² P (doublet - P) 二重項の P 状態

問題 5.1

a) Na-D線遷移の励起状態の電子状態(スペクトル項)を書け。

b) 水素原子の基底状態の電子状態(スペクトル項)を書け。

[直線分子・結合]

$\lambda \text{ (1電子軌道角運動量の分子軸への射影)} = 0, 1, 2, \dots \quad (5.8)$

 $\rightarrow \sigma$ 軌道, π 軌道, δ 軌道, ...

$A \text{ (全電子軌道角運動量の分子軸への射影)} = 0, 1, 2, \dots \quad (5.9)$

 $\rightarrow \Sigma$ 状態, Π 状態, Δ 状態, ...

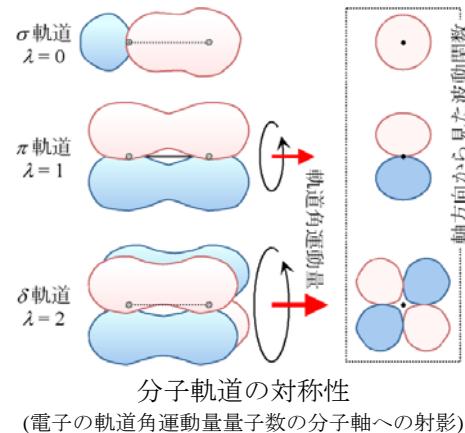
* A には不対電子のみ寄与

多重度

$g_A = 2 (A > 0), 1 (A = 0) \quad (5.10)$

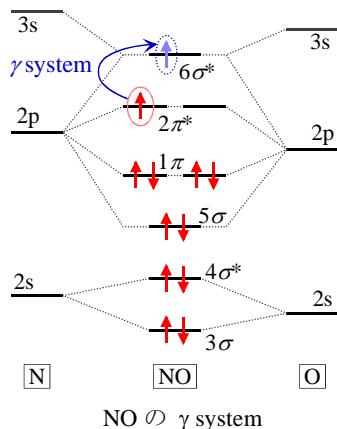
ex.) NO の γ -system $[A^2\Sigma^+ - X^2\Pi]$ ($\sigma^* \leftarrow \pi^*$)

不対電子1個 ... 二重項

基底状態 : 不対電子 $\rightarrow 2\pi$ 軌道 ... $^2\Pi$ 状態励起状態 : 不対電子 $\rightarrow 6\sigma$ 軌道 ... $^2\Sigma$ 状態[資料] NO の紫外 (150–230 nm) 吸収スペクトル (γ system)

NO(一酸化窒素)は紫外領域に規則的な系列の吸収スペクトルを示す。このうち、 γ systemと呼ばれる遷移は、電子基底状態 $X^2\Pi$ から $A^2\Sigma^+$ 状態への遷移に帰属される。以下の出典のスペクトルには、~227 nm(励起状態の振動準位 ' $= 0$ ' への吸収)から~152 nm(' = 10' への吸収)までの吸収が見られる。

スペクトルの出典 : Hideo Okabe, "Photochemistry of Small Molecules," Wiley-Interscience, New York, 1978. (p. 239)



NO の電子基底状態の電子配置は $[1\sigma^2 2\sigma^2 3\sigma^2 4\sigma^2] 5\sigma^2 1\pi^4 2\pi^1$ であり、 γ system 遷移は、主に 2π から 6σ への電子遷移と見なすことができる。(励起状態の電子配置 : $5\sigma^2 1\pi^4 6\sigma^1$) ただし 6σ 軌道は 2σ より $3s\sigma$ の性質を強く示すため、 γ system は主量子数の変化する Rydberg(リュードベリ) 遷移であるとされる。